(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-335776

(P2001-335776A)

(43)公開日 平成13年12月4日(2001.12.4)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 9 K 11/06	602	C 0 9 K 11/06	602	3 K 0 0 7
	630		630	4 C 0 7 2
	650		650	4H049
	6 5 5		655	4 J 1 0 0
C 0 7 D 519/00		C 0 7 D 519/00		

(21)出職番号 特爾2000-218967(P2000-218967)

(22) 出願日 平成12年7月19日(2000.7.19)

(31)優先権主張番号 特願平11-207957

(32)優先日 平成11年7月22日(1999.7.22)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願2000-80734(P2000-80734)

(32)優先日 平成12年3月22日(2000.3.22)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

審査請求 未請求 請求項の数16 〇L (全 52 頁) 最終頁に続く

(72) 発明者 岡田 久

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72)発明者 伊勢 俊大

神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規ヘテロ環化合物、発光素子材料およびそれを使用した発光素子

(57)【要約】

【課題】色純度に優れ、且つ発光特性が良好であり、また繰返し使用時での安定性に優れた発光素子材料および 発光素子を提供する。

【解決手段】下記一般式(I)で表される化合物である ことを特徴とする発光素子材料、及びこれを用いた発光 素子。

一般式 (I)

L- (A)_

(式中、Aは二つ以上の芳香族へテロ環が縮合したヘテ ロ環基を表し、Aで表されるヘテロ環基は同一または異 ってもよい。mは2以上の整数を表す。Lは連結基を表 す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式 (I) で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。

【化1】

一般式 (I)

$$L \leftarrow A)_{\infty}$$

(式中、Aは二つ以上の芳香族へテロ環が縮合したヘテ ロ環基を表し、Aで表されるヘテロ環基は同一または異 なってもよい。mは2以上の整数を表す。Lは連結基を 表す。)

【請求項2】 下記一般式 (II) で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。

【化2】

一般式 (II)

$L \leftarrow B)_{m}$

(式中、Bは二つ以上の5員環および/または6員環の 芳香族へテロ環が縮合したヘテロ環基を表し、Bで表さ れるヘテロ環基は同一または異なってもよい。mは2以 上の軽数を表す。Lは連結基を表す。)

【請求項3】 下記一般式(III)で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。 【化3】

一般式 (III)



【請求項4】 下記一般式(IV)で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。 【化4】

一般式 (IV)

$$(((N_{\mathbf{v}})) (0,)$$

(式中、XはO、S、Se、TeまたはN-Rを表す。 Rは本素原子、脂肪族炭化水素基、アリール基またはへ テロ環基を表す。Q₄は含窒素芳香族ヘテロ環を形成す Sに必要な原子群を表す。mは2以上の整数を表す。L は連結基を表す。)

【請求項5】 下記一般式 (V) で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。

【化5】

一般式 (V)

$$L = \left(\left\langle \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \right\rangle_{s} \right)_{s}$$

(式中、 X_6 はO、SまたはN-Rを表す。Rは水素原 テ、脂肪族炭化水素基、Tリール基またはOテロ環基を 表す。 Q_6 はG日銀合窓業芳各族Oテロ環を形成するに と要な原子群を表す。mは2以上の整数を表す。Lは連 結束を表す。D

【請求項6】 下記一般式 (VI) で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。 【化6】

一般式 (VI)

$$L = \left(\left\langle \left\langle \left\langle \right\rangle \right\rangle \right\rangle \right)$$

(式中、 $X_{\rm c}$ はO、SまたはN-Rを表す。Rは水素原 干、脂肪族炭化水素基、Tりール基またはヘテロ環基を 表す。 $Q_{\rm c}$ は6 員の合意業芳香族ヘテロ環を形成するに 必要な原子群を表す。nは2ないし8の整数を表す。Lは \pm 結基を表す。)

【請求項7】 下記一般式 (VII)で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。 【化7】

一般式 (VII)

$$L - \left(\left\langle \begin{array}{c} N \\ N \\ \end{array} \right\rangle \right)_{n}$$

(式中、Rは水素原子、脂肪族炭化水素基、アリール基 またはヘテロ療基を表す。Qrは6員の含窒素芳香族へ テロ環を形成するに必要な原子群を表す。nは2ないし 8の整数を表す、Lは連結基を表す。)

【請求項8】 下記一般式 (VIII) で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。 【化8】

一般式 (VIII)

(式中、 Q_{81} 、 Q_{82} およびは Q_{83} は、それぞれ6員の含 窒素芳香族へテロ環を形成するに必要な原子群を表す。 R_{81} 、 R_{82} および R_{83} は、それぞれ水素原子、脂肪族炭 (式中、 R_{101} 、 R_{102} および R_{103} は、それぞれ水素 原子、脂肪族炭化水素基、アリール基またはヘテロ環基 を表す。 R_{104} 、 R_{106} および R_{106} は、それぞれ置換 基を表す。 p_1 、 p_2 および p_3 は、それぞれ0 ないし 3の整数を表す。)

【請求項11】 下記一般式(XI) で表される化合物 であることを特徴とする発光素子材料。 【化11】

$$L \left(\begin{array}{c} N \\ N \end{array} \right) Q_{3}$$

(式中、 Q_3 は芳香族へテロ環を形成するに必要な原子 群を表す。 R_{11} は水素原子または置換基を表す。mは2以上の整数を表す。Lは連結基を表す。)

【請求項12】 一対の電極間に発光層もしくは発光層 を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、少なくとも一層が請求項1~11記載の一般式 (1)~(XI)で表される化合物の少なくとも一種を

含有する層であることを特徴とする発光素子。 【請求項13】 一対の電極間に発光層もしくは発光層 を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、かなくとも一個が確求項1~11配譜の一般式

(I) ~ (XI) で表される化合物の少なくとも一種を

(式中、Q₉₁、Q₉₂およびはQ₉₀は、それぞれ6員の含 窒素芳香燥~テロ環を形成するに必要な原子酵を表す。 R₉₁、R₉₂はたびR₉3は、それぞれ水素原子、脂肪族原 化水素基、アリール基またはヘテロ環基を表す。) 【請求項10】 下記一般式 (X) で表されることを特 機とする化合数

【化10】

Rios ポリマーに分散した層であることを特徴とする発光素 子。

【請求項14】 一対の電極順に発光層もしくは発光層を含む複数の有機や効準操を形成した発光業子において、発光層と機能との間のかなくとも一層が解項1~11記載の一般式(I)~(XI)で表される化合物を少なくとも一種含有する層であることを特徴とする発光業子。

【請求項 15】 一対の電極間に発光層もしては発光層 を含む複数の有機化合物構層を形成した発光源子におい て、青色発光器と陰極との間の少なくとも一層が請求項 1~11記載の一般式 (I)~ (XI)で表される化合 物を少なくとも一個含有する層であることを特徴とする 発光素子。

【請求項16】 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薬層を形成した発光薬子において、請求項1~11記載の一般式(1)~(X1)で表される化合物を少なくとも一種含有する層に青色発光材料を含有することを特徴とする発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規ヘテロ環化合 物に関する。詳しくは電気エネルギーを光に変換して発 光できる発光素子用材料および発光素子に関し、表示素 子、ディスプレイ、パックライト、電子写真、照明光 源、記録光源、読み取り光源、標識、発板、インテリア 等の分野に好適に使用できる発光素子に関する。 【0002】

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発 が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低 電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な妻 赤弟子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸 着により有機神験を形成する発光素子が知られている

(アプライド フィジックス レターズ, 51巻, 913頁, 1987年)。この文献に記載された発光素子は トリス (8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム錯体

(A1q) を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料 (アミン化合物) と積層させることにより、従来の単層 型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。

【0003】上記積層型発光素子の発光効率を更に改良 する手段として、蛍光色素をドープする方法が知られて いる。例えば、ジャーナル オブ アプライド フィジ ックス 65巻、3610頁、1989年に記載のクマ リン色素をドープした発光素子はドープしない素子に比 べて発光効率が大幅に向上している。この場合、用いる 蛍光性化合物の種類を変えることにより所望の波長の光 を取り出すことが可能であるが、電子輸送材料としてA 1 gを用いた場合、高輝度を得るために駆動電圧を高く すると、ドープした蛍光性化合物の発光の他にAlaの 緑色発光が観測されてくるため、青色を発光させる場合 には色維度の低下が問題になり、色維度を低下させない ホスト材料の開発が望まれている。これを改良するもの として特開平10-92578号、米国特許第5766 779号に特定のインドール誘導体が開示されている が、記載の化合物では高輝度発光のためには駆動電圧を 高くする必要があるなどの問題があり、低電圧で高輝度 発光可能な化合物の開発が望まれていた。また、発光効 率を高める方法として3-(4-ピフェニルイル)-4 -フェニル-5- (4-tert-ブチルフェニル) -1、2、4-トリアゾール (TAZ)、バソクプロイン

(BCP) などのホールプロック性材料を用いる方法が 報告されているが、これら公知の材料では耐分性、特に 高服条存経時、連続発光での東子劣化が大きな問題となっていた。また、色純度が良好で発光効率が高い従来の 来子は電荷輸送材料中に蛍光性色素を微量ドープしたも のであり、製造上来与特性の所理性を出すこかが難しい ことや、色素の耐久性が低いために長時間使用した場合 に輝度の低下、色変化が長きるなどの問題があった。こ たを解決する下泉として電体能機能と発光体能を業れ た材料の開発が望まれているが、これまで開発された材 杯では蛍光性色素を高濃度で用いると、濃度消光、金 能により高階で乗れば無いといった間隔があった。

【0004】一方、有機発光素子において高輝度発光を 実現しているものは有機物質を真空蒸着によって積層し ている素子であるが、製造工程の簡略化、加工性、大面 補化等の観点から塗布方式による素子作製が望ましい。 しかしながら、従来の除布方式で作製した素子では発光 輝度、発光効率の点で蒸着方式で作製した素子に劣って おり、高輝度、高効率発光化が大きな課題となってい た。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 本発明の第一の目的 は、発光特性が良好であり、また繰り返し使用時での安 定性に優れた発光素子用材料および発光素子の提供にあ る。本発明の第二の目的は、色純度に優れた発光素子お よびそれを可能にする発光素子用材料の提供にある。本 発明の第二の目的は、各種電子デバイス等に有効な新規 ペテロ機化や動を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】この課題は下記手段によって達成された。

【0007】 [1] 下記一般式 (I) で表される化合物 であることを特徴とする発光素子材料。 【0008】

【化12】

→**粉**式 (1)

版式 (1)

$$L \leftarrow A)_n$$

【0009】 (式中、Aは二つ以上の芳香族へテロ環が 縮合したヘテロ環基を表し、Aで表されるヘテロ環基は 同一または異なってもよい。mは2以上の整数を表す。 Lは連結基を表す。)

[2] 下記一般式 (II) で表される化合物であることを 特徴とする発光素子材料。

【0010】 【化13】

一般式 (II)

L -(B),

【0011】 (式中、Bは二つ以上の5員標および/または6員環の芳香族~テロ環が縮合した~テロ環基を表し、Bで表される~テロ環基は同一または異なってもよい。mは2以上の繁数を表す。1 は連結基を表す。)

[3] 下記一般式 (III)で表される化合物であることを 特徴とする発光素子材料。

【0012】 【化14】

一般式 (III)

$$L = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} N \\ v \end{pmatrix} & Q_3 \end{pmatrix}$$

【0013】(式中、XはO、S、Se、TeまたはN - Rを表す。Rは水薬原子、脂肪族炭化水薬基、アリー ル基またはヘテロ環基を表す。Qaは芳香族ヘテロ環を 形成するに必要な原子群を表す。mは2以上の整数を表 す。Lは連結基を表す。 [4] 下記一般式(IV) で表される化合物であることを 特徴とする発光素子材料。

[0014]

【化15】

一般式 (IV)

 $\Gamma - \left(\leqslant_{N}^{X} \widetilde{\mathbb{J}} \cdot \delta^{*} \right)^{n}$

【0015】 (式中、XitO、S、S c、T c またはN-Rを表す。Rit本無所子、脂肪族原化水本系、アリール基またはヘテロ環基を表す。Q4は含窒素芳香族ヘテロ環を形成するに必要な原子群を表す。mit2以上の整数を表す、Li連結基を安す。)

[5] 下記一般式(V) で表される化合物であることを 特徴とする発光素子材料。

[0016]

【化16】

一般式 (V)

 $[0\ 0\ 1\ 7]$ (式中、 $X_{\rm s}$ はO、SまたはN-Rを表 す。Rit水素原子、脂肪族以化水素基、アリール基また はヘテロ環基を表す。 $Q_{\rm s}$ は6 員の含意素芳香族ヘテロ 環を形成するに必要な原子群を表す。mは2以上の整数 を表す。Lは連結基を表す。)

[6] 下記一般式 (VI) で表される化合物であることを 特徴とする発光素子材料。

[0018]

【化17】

一般式 (VI)

 $L = \left(\begin{pmatrix} N \\ Y \end{pmatrix} \right) = \emptyset_0$

【0019】(式中、X_eはO、SまたはN-Rを表 す。Riな未無原子、脂肪族於化水素基、アリール基また はヘテロ環基を表す。Q_eは6員の含意素芳香族ヘテロ 環を形成するに必要な原子群を表す。nは2ないし8の 骸数を表す、Lは連結基を表す。)

[7] 下記一般式 (VII)で表される化合物であることを 特徴とする発光素子材料。

[0020]

【化18】

一般式 (VII)

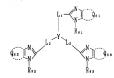
$$L = \left(\left\langle \begin{array}{c} N \\ N \\ R \end{array} \right\rangle_n$$

【0021】(式中、Rは木素原子、脂肪族炭化木素基、アリール基またはヘテロ環基を表す。Q7は6員の含窒素芳香族ヘテロ環を形成するに必要な原子群を表す。nは2ないし8の整数を表す。Lは連結基を表す。)

[8] 下記一般式 (VIII) で表される化合物であること を特徴とする発光素子材料。

【0022】 【化19】

一般式 (VIII)



[9] 下記一般式 (IX) で表されることを特徴とする化 合物。

[0024]

【化20】

一般式 (IX)

[0025] (式中 $^{4.9}$ Q $_{01}$ 、Q $_{02}$ お 4 比はQ $_{03}$ は、それ ぞれ 6[0合業素芳香族へテロ環を形成するに必要な原子群を表す。 R_{01} 、 R_{02} および R_{03} は、それぞれ水素原子、脂肪族族化水素基、アリール基またはヘテロ環基を表す。)

[10] 下記一般式(X) で表されることを特徴とする 化合物。

[0026]

【化21】

 $\left[0027\right]$ (式中、 R_{101} 、 R_{102} および R_{103} は、それぞれ水素原子、脂肪族族化木素基、アリール基またはヘテロ氨基を表す。 R_{104} 、 R_{105} および R_{106} は、それぞれ経典基を表す。 p_1 、 p_2 および p_3 は、それぞれ経典基を表す。 p_1 、 p_2 および p_3 は、それぞれのないし3の整数を表す。 p_3

[11] 下記一般式 (XI) で表される化合物であることを特徴とする発光素子材料。

[0028] [化22]

一般式 (XI)

$$L \left(\begin{array}{c} N \\ N \end{array} \right) Q_{s}$$

【0029】 (式中、Q。 は芳香族ヘテロ環を形成する に必要な原子群を表す。 R₁は水素原子または直換基を ます。 mは2以上の整数を支末。 しは連結を表す。) 【12] 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複 数の有線化合物薄層を形成した発光業子において、少な くとも一層が [1] ~ [11] 記載の一般式 (1) ~ (XI) で表される化合物の少なくとも一種を含有する 層であることを特徴とする差光素子。 [13] 一対の電極間に発光幕もしくは発光層を含む複 [13] 一対の電極間に発光幕トしくは発光層を含む複

「13] 一対の電機間に発光層とくは発光層を含む複数の有機化合物機関を形成した発光素子において、少なくとも一層が [1] ~ [11] 記載の一般式 (1) ~ (XI) で表される化合物の少なくとも一種なポリマーに分散した層であることを特徴とする発光素子。
[14] 一対の電極間に発光層とくは発光素合む複

数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、発光 層と陰極との間の少なくとも一層が [1] ~ [1] 記 載の一般式 [1) ~ (X I) で表される化合を少なく とも一種含有する層であることを特徴とする発光素子。 [15] 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む極 数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、青色 発光層と陰眩との間の少なくとも一層が [1] ~ [1 1] 記載の一般式 [1] ~ (X I) で表される化合物を 少なくとも一種含有する層であることを特徴とする発光 素子。 [16] 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子において、 (1) ~ (11) 記載の一般式(I) ~ (XI) で表される化合物を少なくとも一種含有する層に青色発光材料

を含有することを特徴とする発光素子。 【0030】

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。まず、一般式(I)で表される化合物について説 明する。Aは二つ以上の芳香族へテロ環が縮合したヘテ ロ環基を表し、Aで表されるヘテロ環基は同一または異 なってもよい。Aで表されるヘテロ環基として好ましく は5 目環または6 目環の芳香族ヘテロ環が綜合したもの であり、より好ましくは2ないし6個、更に好ましくは 2ないし3個、特に好ましくは2個の芳香炸ヘテロ環が 縮合したものである。この場合のヘテロ原子として好ま しくは、N、O、S、Se、Te原子であり、より好ま しくはN、O、S原子であり、更に好ましくはN原子で ある。Aで表されるヘテロ環基を構成する芳香族ヘテロ 環の具体例としては、例えばフラン、チオフェン、ピラ ン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、 ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、チアゾール、オキ サゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、チアジ アゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、セレナゾ ール、テルラゾールなどが挙げられ、好ましくはイミダ ゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジ ン、ピリダジン、チアゾール、オキサゾールであり、よ り好ましくはイミダゾール、チアゾール、オキサゾー ル、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジンであ

【0031】Aで表される縮合操の具体例としては、例 えばインドリジン、プリン、プテリジン、カルボリン、 ピロコイミダゲール、ピロカリアゾール、ピラゾロイ ミダゾール、ピラゾロトリアゾール、ピラノロピリミジ ン、ピラソロトリアジン、トリアゾロピリジシ、テトラ ザインデン、ピロロイミダゾール、ピロトリアゾー ル、イミダソイミダゾール、イミダゾピリジン、イミダ ゾピラジン、イミダゾピリミジン、オキサゾロピラジン、オキサ ゾロピリミジン、オキサソロピラジシ、オキサ ゾロピリミジン、オキサリロピラジシ、デアゾロピリ ジン、チアソロビラジン、チアソロビリミジン、チアソ ロビリダジン、ピリジノビラジン、ビラジノビリダジン、 ビラジノビリダジン、ナフチリジン、イミダソトリアジ ンなどが挙げられ、好ましくはイミダソビリジン、イミ ダゾビラジン、イミダソビリミジン、イミダソビリダジ 、オキサゾロビリジン、オキサゾロビラジン、オキサ ゾロビリミジン、オキサゾロビリミジン、チアゾロビリ ジン、チアソロビラジン、チアゾロビリ ジン、ゲアソロビラジン、ゲアジロビリミジン、チアソ あり、更に貯ましくはイミダソビリジン、オキサゾロビ リジン、チアソロビリジン、ピラジノビラジン・ピラジンであり、実に貯ましくはイミダソビリジン、ピラジン、ピラジ ノビラジンであり、特に好ましくはイミダソビリジンで ある。

【0032】Aで表されるヘテロ環基は更に他の環と縮 合してもよく、また置換基を有してもよい。Aで表され るヘテロ環基の置換基としては、例えばアルキル基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~10であり、例えばメチ ル、エチル、iso-プロビル、tert-ブチル、n ーオクチル、nーデシル、n-ヘキサデシル、シクロプ ロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げら れる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~30、 より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数 2~10であり、例えばビニル、アリル、2-プテニ ル、3-ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニル 基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数 2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例え ばプロパルギル、3-ペンチニルなどが挙げられ る。)、アリール基(好ましくは炭素数6~30、より 好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~ 12であり、例えばフェニル、p-メチルフェニル、ナ フチルなどが挙げられる。)、アミノ基 (好ましくは炭 素数0~30、より好ましくは炭素数0~20、特に好 ましくは炭素数0~10であり、例えばアミノ、メチル アミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベンジル アミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノなどが挙げ られる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~10であり、例えばメトキシ、エトキシ、プト キシ、2-エチルヘキシロキシなどが挙げられる。)、 アリールオキシ基 (好ましくは炭素数6~30、より好 ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~1 2 であり、例えばフェニルオキシ、1-ナフチルオキ シ、2-ナフチルオキシなどが挙げられる。)、アシル 基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数 1~20、特に好ましくは炭素数2~12であり、例え ばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが 挙げられる。)、アルコキシカルボニル基(好ましくは 炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に 好ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカル ボニル、エトキシカルボニルなどが挙げられる。)、ア リールオキシカルボニル基 (好ましくは炭素数7~3 0、より好ましくは炭素数7~20、特に好ましくは炭 素数7~12であり、例えばフェニルオキシカルボニル などが挙げられる。)、アシルオキシ基(好ましくは炭 素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好 ましくは炭素数2~10であり、例えばアセトキシ、ベ ンゾイルオキシなどが挙げられる。)、アシルアミノ基 (好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2 ~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えば アセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられ る。)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭 素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好 ましくは炭素数2~12であり、例えばメトキシカルボ ニルアミノなどが挙げられる。)、アリールオキシカル ボニルアミノ基 (好ましくは炭素数7~30、より好ま しくは炭素数7~20、特に好ましくは炭素数7~12 であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが 挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素 数 $1\sim30$ 、より好ましくは炭素数 $1\sim20$ 、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメタンスルホニル アミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられ る。)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0~3 より好ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭 素数0~12であり、例えばスルファモイル、メチルス ルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスル ファモイルなどが挙げられる。)、カルバモイル基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばカル バモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイ ル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アル キルチオ基(好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数 $1\sim20$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim12$ であ り、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられ る。)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6~30、 より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数 6~12であり、例えばフェニルチオなどが挙げられ る。)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~30、よ り好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1 ~12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられ る。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼン スルフィニルなどが挙げられる。)、ウレイド基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばウレ イド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げら れる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~3 より好ましくは炭素数1~20.特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド、フ

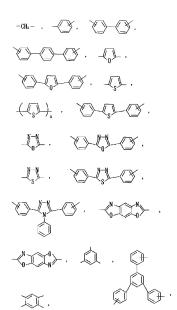
ェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキシ 基、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、 塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ 基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、ス ルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~1 2であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素 原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピリ ジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モル ホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベ ンズチアゾリル、カルバゾリル、アゼピニルなどが挙げ られる。)、シリル基(好ましくは炭素数3~40、よ り好ましくは炭素数3~30、特に好ましくは炭素数3 ~24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニル シリルなどが挙げられる。) などが挙げられる。これら の置換基は更に置換されてもよい。また置換基が二つ以 上ある場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な 場合には連結して環を形成してもよい。

【0033】Aで表される〜テロ環基の関格基として射ましくは、アルキル基、アルケニル基、アルキール基、アリール本、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシカルボニル基、アシルオをシカルボニルス・アンルオンカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイル基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、

カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ス ルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基であ り、より好ましくはアルキル基、アルケニル基、アリー ル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原 子、シアノ基、ヘテロ環基であり、更に好ましくはアル キル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ 基、芳香族ヘテロ環基であり、特に好ましくはアルキル 基、アリール基、アルコキシ基、芳香族ヘテロ環基であ る。mは2以上の整数を表し、好ましくは2ないし8、 より好ましくは2ないし6、更に好ましくは2ないし4 であり、特に好ましくは2または3であり、最も好まし くは3である。Lは連結基を表す。Lで表される連結基 として好ましくは、単結合、C、N、O、S、Si、G eなどで形成される連結基であり、より好ましくは単結 合、アルキレン、アルケニレン、アルキニレン、アリー レン、二価のヘテロ環(好ましくは芳香族ヘテロ環であ り、より好ましくはアゾール、チオフェン、フラン環か ら形成される芳香族ヘテロ環などである。) およびNと これらの組合わせから成る基であり、更に好ましくはア リーレン、二価の芳香族へテロ環およびNとこれらの組 合わせから成る基である。

【0034】 Lで表される連結基の具体例としては、単結合の他、例えば以下のものが挙げられる。 【0035】

【化23】



[0036]

【化24】

[0037]

[0038]

-11-

【0039】Lで表される連結基は置換基を有してもよく、置換基としては例えばれて表されるヘケロ環基の関 焼基として挙げたものが適用できる。Lの関検基として 好ましくはアルキル基、アルウニル基、アルキニル基、 アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル 基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテル要基、アリル基で あり、より好ましくはアルキル基、アルール本、アル キニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ 基、アロゲン原子、シアノ基、芳香族ヘテロ環基であり、更に好ましくはアルキル基、アリール基、芥子族へ テロ保証である。

【0040】一般式(1)で表される化合物のうち、好ましくは下記一般式(11)で表される化合物である。 【0041】 【化27】 一般式 (II)

L ← B).

【0042】式中、m、Lit、それぞれ一般式(I)におけるそれらと同裔であり、また好ましい範囲も同様である。Bは二つ以上の5員無対まび/または自員環の芳香族へテロ環が縮合したヘテロ環基を表し、Bで表されるヘテロ環基として対ましては5員環または自員環の芳香族へテロ環が2ないし6個縮合したものであり、更に好ましくは2ないし3個、特に好ましくは2個の芳香族のテロ環が縮合したものである。この場合のヘテロ原子として好ましくは、N、O、S、Se、Tの原子であり、より新ましくはい、O、S、原子であり、更に好ましくは、N、O、S、原子であり、更に対ましる方香族へテロ環の具体例としては、例えばフラン、チオ

フェン、ビラン、ビロール、イミダソール、ピラゾール、ビリジン、ビラジン、ビリミジン、ピリダジン、チリアジン、 アゾール、オキサゾール、イソチアゾール、イソオキサ ゾール、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアゾ ール、セレナソール、デルラゾールなどが挙げられ、好 ましくはイミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジ ン、ピリミジン、ピリダン、チアゾール、オキサゾー ルであり、より好ましくはイミダゾール、チアゾール、 オキサゾール、ピリジン、ピリミジン、ピリ マジンである。

【0043】Bで表される縮合環の具体例としては、例 えばインドリジン、プリン、プテリジン、カルボリン、 ピロロイミダゾール、ピロロトリアゾール、ピラゾロイ ミダゾール、ピラゾロトリアゾール、ピラゾロビリミジ ン、ピラゾロトリアジン、トリアゾロピリジン、テトラ ザインデン、ピロロイミダゾール、ピロロトリアゾー ル、イミダゾイミダゾール、イミダゾピリジン、イミダ ゾピラジン、イミダゾピリミジン、イミダゾピリダジ ン、オキサゾロビリジン、オキサゾロビラジン、オキサ ゾロビリミジン、オキサゾロビリダジン、チアゾロピリ ジン、チアゾロピラジン、チアゾロピリミジン、チアゾ ロピリダジン、ピリジノピラジン、ピラジノピラジン、 ピラジノビリダジン、ナフチリジン、イミダゾトリアジ ンなどが挙げられ、好ましくはイミダゾピリジン、イミ ダゾピラジン、イミダゾピリミジン、イミダゾピリダジ ン、オキサゾロピリジン、オキサゾロピラジン、オキサ ゾロピリミジン、オキサゾロピリダジン、チアゾロピリ ジン、チアゾロピラジン、チアゾロピリミジン、チアゾ ロピリダジン、ビリジノピラジン、ピラジノピラジンで あり、更に好ましくはイミダゾビリジン、オキサゾロビ リジン、チアゾロビリジン、ビリジノビラジン、ビラジ ノビラジンであり、特に好ましくはイミダゾピリジンで ある。Bで表されるヘテロ環基は置換基を有してもよ く、置換基としては一般式(I)におけるAで表される ヘテロ環基の置換基として挙げたものが適用でき、また 好ましい情格基も同様である。

【0044】一般式(1)で表される化合物のうち、より好ましくは下記一般式(III)又は(X1)で表される化合物である。

[0045]

[0045

一般式 (III)

$$L \left(\left\langle \begin{array}{c} X \\ X \end{array} \right\rangle \left[Q_3 \right)$$

--修式 (XI)

$$L = \begin{pmatrix} N & Q_s \end{pmatrix}$$

【0046】 一般式 (III) について説明する。m、 L は、それぞれ一般式(1)におけるそれらと同義であ り、また好ましい範囲も同様である。XはO、S、S e、TeまたはN-Rを表す。Rは水素原子、脂肪族炭 化水素基、アリール基またはヘテロ環基を表す。Q。は 芳香族へテロ環を形成するに必要な原子群を表す。Rで 表される脂肪族炭化水素基として好ましくは、アルキル 基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数 $1\sim12$ 、特に好ましくは炭素数 $1\sim8$ であり、例えば メチル、エチル、iso-プロビル、tert-ブチ ル、n-オクチル、n-デシル、n-ヘキサデシル、シ クロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが 挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~ 20. より好ましくは炭素数2~12. 特に好ましくは 炭素数2~8であり、例えばビニル、アリル、2-ブテ ニル、3-ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニ ル基 (好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素 数2~12、特に好ましくは炭素数2~8であり、例え ばプロパルギル、3-ペンチニルなどが挙げられる。) であり、より好ましくはアルキル基、アルケニル基であ

【0047】Rで表されるアリール基として好ましくは 炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に 好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル、2 ーメチルフェニル、3-メチルフェニル、4-メチルフ ェニル、4-メトキシフェニル、3-トリフルオロメチ ルフェニル、ペンタフルオロフェニル、2-ビフェニリ ル、3ーピフェニリル、4ーピフェニリル、1ーナフチ ル、2-ナフチル、1-ピレニルなどが挙げられる。R で表されるヘテロ環基は、単環または縮環のヘテロ環基 (好ましくは炭素数1~20、好ましくは炭素数1~1 2、更に好ましくは炭素数2~10のヘテロ環基)であ り、好ましくは窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン 原子の少なくとも一つを含む芳香族へテロ環基である。 Rで表されるヘテロ環基の具体例としては、例えばピロ リジン、ピペリジン、ピロール、フラン、チオフェン、 イミダゾリン、イミダゾール、ベンズイミダゾール、ナ フトイミダゾール、チアゾリジン、チアゾール、ベンズ チアゾール、ナフトチアゾール、イソチアゾール、オキ サゾリン、オキサゾール、ベンズオキサゾール、ナフト

オキサゾール、イソオキサゾール、セレナゾール、ベン ズセレナゾール、ナフトセレナゾール、ビリジン、メン リン、イツキノリン、インドール、インドンニン、ピラ ゾール、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジ ン、インがゾール、プリン、フタラジン、ナフチリジ ン、フェナントリジン、ブテリジン、フェナントロリ ン、テトラザインデンなどが挙げられ、好ましくはフラ ミジン、ピリダジン、トリアジン、フタラジン、ナフチ リジン、キノキサリン、キナゾリンであり、より好まし くはフラン、チオフェン、ピリジン、キノリンであり、 まりなました。

【0048】 Rで表される脂肪族炭化水素基、アリール 基、ヘテロ環亜は直接基を有してもよく、直接基とし に一般式(1) におけるんで変されるヘテロ環基の置換 基として挙げたものが適用でき、また好ましい電機基も 同様である。 Rとして好ましくは、アルキル基、アリー ル基、芳香族〜テロ環基であり、より好ましくはアリー ル基、芳香族〜テロ環基であり、更に好ましくはアリー ル基、芳香族〜アーロ環基であり、更に好ましくはアリー ル基、芳香族▽アール基である。

【0049】Xとして好ましくはO、S、N-Rであり、東り好ましくはO、N-Rであり、更に好ましくは
N-Rであり、特に好ましくはN-Ar(Arはアリール基、秀香族アゾール基であり、より好ましくは炭素的
6~30のアリール基、炭素数2~30の芳香族アゾー
基 美しなましくは炭素数6~20のアリール基、炭素数2~16の芳香族アゾール基、特に好ましくは炭素数6~12のアリール基、炭素00~10の芳香族アゾール基であり。)である。)である。

【0050】Qaは芳香族ヘテロ環を形成するに必要な 原子群を表す。Qaで形成される芳香族へテロ環として 好ましくは5または6員の芳香族へテロ環であり、より 好ましくは5または6員の含窒素芳香族ヘテロ環であ り、更に好ましくは6員の含窒素芳香族へテロ環であ る。Q。で形成される芳香族ヘテロ環の具体例として は、例えばフラン、チオフェン、ピラン、ピロール、イ ミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミ ジン、ピリダジン、チアゾール、オキサゾール、イソチ アゾール、イソオキサゾール、チアジアゾール、オキサ ジアゾール、トリアゾール、セレナゾール、テルラゾー ルなどが挙げられ、好ましくはピリジン、ピラジン、ピ リミジン、ピリダジンであり、より好ましくはピリジ ン、ピラジンであり、更に好ましくはピリジンである。 Q。で形成される芳香族ヘテロ環は更に他の環と縮合環 を形成してもよく、また置換基を有してもよい。置換基 としては一般式(I)におけるAで表されるヘテロ環基 の置換基として挙げたものが適用でき、また好ましい置 換基も同様である。

【0051】一般式 (III)で表される化合物のうち、更

に好ましくは下記一般式 (IV) で表される化合物である。

【0052】 【化29】

一般式 (IV)

 $L - \left(\begin{pmatrix} N \\ X \end{pmatrix} \bigcirc Q_1 \right)_{n}$

【0053】式中、m、Lは、それぞれ一般式(I)に おけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様で ある。Xは一般式 (III)におけるそれと同義であり、ま た好ましい範囲も同様である。Q。は含窒素芳香族ヘテ ロ環を形成するに必要な原子群を表す。Qaで形成され る含窒素芳香族ヘテロ環として好ましくは5または6員 の含窒素芳香族ヘテロ環であり、より好ましくは6員の 含窒素芳香族ヘテロ環である。Q。で形成される含窒素 芳香族へテロ環の具体例としては、例えばピロール、イ ミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミ ジン、ピリダジン、チアゾール、オキサゾール、イソチ アゾール、イソオキサゾール、チアジアゾール、オキサ ジアゾール、トリアゾール、セレナゾール、テルラゾー ルなどが挙げられ、好ましくはピリジン、ピラジン、ピ リミジン、ピリダジンであり、より好ましくはピリジ ン、ピラジンであり、更に好ましくはピリジンである。 Q。で形成される芳香族ヘテロ環は更に他の環と縮合環 を形成してもよく、また置換基を有してもよい。置換基 としては一般式 (I) におけるAで表されるヘテロ環基 の置換基として挙げたものが適用でき、また好ましい置 換基も同様である。

【0054】一般式 (III)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式 (V) で表される化合物である。

[0055] [化30]

一般式 (V)

 $L = \left(\left\langle \left\langle \left\langle \right\rangle_{X_{\delta}} \right\rangle_{S_{\delta}} \right)$

【0056】式中、m、Lit、それぞれ一般式 (1) におけるそれらと同範であり、また好ましい範囲も同様である。X。はへ、SまたはトーRを妻す。R に一般式 (1) におけるそれと同様であり、また好ましい範囲も同様である。Q。は6員の合室素芳香族ペテロ環を形成するに必要な版下群を表す。Q。で形成される6員の合室素芳香族ペテロ環の具体例としては、例えばビリジン、ビリジン、ビリジン、ビリジン、ビリジン、ビリジン、ビリジンであり、東に付ましくはビリジンであり、マビタジンであり、東に好ましくはビリジンである。Q。で形成される60で変素芳香族ペテロ環境でである。Q。で形成される60で変素芳香族ペテロ環境で更い機能でいる。

合係を形成してもよく、また置換基を有してもよい。置 換基としては一般式 (1) におけるAで表されるヘテロ 環基の置換基として挙げたものが適用でき、また好まし い置換基も同様である。

【0057】一般式(III)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(VI)で表される化合物であ

【0058】 【化31】

一般式 (VI)



 $[0 \ 0 \ 5 \ 9]$ 式中、Lは一般式(I)におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 X_G は一般式(V)における X_G と同義であり、また好ましい範囲も同様である。 Q_G は一般式(V)における Q_G と同義であり、また好ましい統囲も同様である。 112 ないしるの整数を表し、好ましくは2 ないしも、より好ましくは2 ないしょであり、更に好ましくは2 ないしょであり、更に好ましくは2 ないしゃであり、更に好ましくは2 またはるであり、特に好ましくは3 である。一般式(III)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(<math>III)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(III)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(III)で表される化合物のうち、

[0060] [化32]

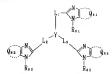
一般式 (VII)

$$L = \left(\left\langle \begin{matrix} N \\ N \end{matrix} \right\rangle \right)_{n}$$

【0061】式中、Lは一般式(1)におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様である。Rは一般式(III)におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様である。Q,は一般式(V)におけるGaと同義であり、また好ましい範囲も同様である。nは一般式(V)におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様である。から、また好ましい範囲も同様である。

【0062】一般式(III)で表される化合物のうち、更 に好ましくは下記一般式(VIII)で表される化合物であ る。

[0063] [化33] 一般式 (VIII)



【0064】式中、R₈₁、R₈₂およびR₈₃は、それぞれ 一般式 (III)におけるRと同義であり、また好ましい範 囲も同様である。Qai、QaoおよびQaaは、それぞれ一 般式(V)におけるQ。と同義であり、また好ましい範 囲も同様である。 L_1 、 L_2 および L_3 は、それぞれ一般 式(I)におけるLと同義である。L、、L。、L。と して好ましくは、単結合、アリーレン、二価の芳香族へ テロ環およびこれらの組合わせから成る連結基であり、 より好ましくは単結合、ベンゼン、ナフタレン、アント ラセン、ピリジン、ピラジン、チオフェン、フラン、オ キサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、チアジア ゾール、トリアゾールおよびこれらの組合わせから成る 連結基であり、更に好ましくは単結合、ベンゼン、チオ フェンおよびこれらの組合わせから成る連結基であり、 特に好ましくは単結合、ベンゼンおよびこれらの組合わ せから成る連結基であり、最も好ましくは単結合であ る。L、、L。、L。は置換基を有してもよく、置換基 としては一般式(I)におけるAで表されるヘテロ環基 の置換基として挙げたものが適用できる。

【0065】Yは葉栗原子または1,3,5 ペンゼントリイル基を表すが、後者は2,4,6 化に置換基を してもよく、置換基としては例えばアルキル基、アリール基、ハロゲン原子などが挙げられる。Yとして好ましくは変原子または無置換1,3,5 ペンゼントリイル基であり、より好ましくは軽度換1,3,5 ペンゲントリイル基である。一般式 (III)で表される化合物のうち、特に好ましくは下記一般式 (IX) で表される化合物のかるみ。

[0066]

【化34】

【0067】式中、"R₉₁、R₉₂およびR₉₃は、それぞれ 一般式 (III)におけるRと同義であり、また好ましい範 囲も同様である。 Q_{01} 、 Q_{02} および Q_{03} は、それぞれ一般式 (V) における Q_{05} と同義であり、また好ましい範則も同様である。一般式 (IIII)で表される化合物のうち、最も好ましくは下記一般式 (X) で表される化合物

である。 【0068】 【化35】

[0069] 式中、R₁₀₁、R₁₀₂ およびR₁₀₃は、それぞれ一般式(X)におけるRと同義であり、また好ましい範囲も同様である。R₁₀₄ x R₁₀₅ およびR₁₀₆は、それぞれ置換基を支し、置換基としては一般式(I)におけるAで表される~テロ環基の置換基として学げたものが適用でき、また好ましい置換基も同様である。また可能な場合、度換集団士が連結して策を形成してもよい。p₁、p₂ およびp₃ は、それぞれのないし3の概数を表し、好ましくはひないし2、より好ましくけ0または、T² でにかましくはひないし2、より好ましくけ0または、T² でにかましくは0ないし2、より好ましくけ0または、T² でにかましくは0ないし2、より好ましくけ0または、T² でにかましくは0である。

【0070】次に一般式 (XI) について説明する。 m、Lは、それぞれ一般式(I)におけるそれらと同義 であり、また好ましい範囲も同様である。Q。は一般式 (III)におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も 同様である。R.,は水素原子または置換基を表す。R., で表される置換基としては例えば一般式(I)における Aで表されるヘテロ環基の置換基として挙げたものが適 用できる。 R., で表される置換基として好ましくは、脂 肪族炭化水素基、アリール基、芳香族へテロ環基であ り、より好ましくは、アルキル基(好ましくは炭素数1 ~20、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましく は炭素数1~8であり、例えばメチル、エチル、iso ープロピル、tertーブチル、nーオクチル、nーデ シル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペン チル、シクロヘキシルなどが挙げられる。)、アリール 基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数 6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例え ばフェニル、2-メチルフェニル、3-メチルフェニ ル、4-メチルフェニル、4-メトキシフェニル、3-トリフルオロメチルフェニル、ペンタフルオロフェニ ル、1-ナフチル、2-ナフチルなどが挙げられ る。) , 芳香族ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~2 0、好ましくは炭素数1~12、更に好ましくは炭素数 2~10の芳香族へテロ環基であり、より好ましくは窒 素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも 一つを含む芳香族へテロ環基である。芳香族へテロ環と

しては、例えばピロリジン、ピペリジン、ピロール、フ ラン、チオフェン、イミダゾリン、イミダゾール、ベン ズイミダゾール、ナフトイミダゾール、チアゾリジン、 チアゾール、ベンズチアゾール、ナフトチアゾール、イ ソチアゾール、オキサゾリン、オキサゾール、ベンズオ キサゾール、ナフトオキサゾール、イソオキサゾール、 セレナゾール、ベンズセレナゾール、ナフトセレナゾー ル、ピリジン、キノリン、イソキノリン、インドール、 インドレニン、ピラゾール、ピラジン、ピリミジン、ピ リダジン、トリアジン、インダゾール、プリン、フタラ ジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シン ノリン、プテリジン、フェナントリジン、プテリジン、 フェナントロリン、テトラザインデン、カルバゾールな どが挙げられ、好ましくはフラン、チオフェン、ピリジ ン、キノリン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、ト リアジン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、 キナゾリンであり、より好ましくはフラン、チオフェ ン、ピリジン、キノリンであり、更に好ましくはキノリ ンである。) であり、更に好ましくはアリール基、芳香 族へテロ環基である。R.,で表される置換基は、更に置 換されてもよく、また可能な場合には連結して環を形成 してもよい。

【0071】一般式 (XI) で表される化合物のうち、より好ましくは下記一般式 (XII) で表される化合物である。

【0072】 【化36】

$$L \left(\begin{array}{c} N \\ R_{11} \end{array} \right) Q_{12}$$

【0073】式中、m、Lは、それぞれ一般式(1) に おけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様で ある。 Q_n は一般式(1V) における Q_n と同義であ り、また好ましい範囲も同様である。R₁₁は一般式(X I)におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

【0074】一般式(XI)で表される化合物のうち、 更に好ましくは下記一般式(XIII)で表される化合物で ある。

【0075】 【化37】

--松式 (XIII)

$$L = \begin{pmatrix} N & Q_{18} \\ R_{11} & N \end{pmatrix}$$

[0076]式中、m、Lは、それぞれ一般式 (1) に おけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様で ある。Q₁は一般式 (V) におけるQ₂と同義であり、 また好ましい範囲も同様である。R₁₁は一般式 (X I) におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様で ある。

【0077】一般式(XI)で表される化合物のうち、 特に好ましくは下記一般式(XIV)で表される化合物で ある。

【0078】 【化38】

【0079】式中、 L_1 、 L_2 、 L_3 およびYは、それぞれの吸式(VIII)におけるそれらと同義であり、また男ましい範囲も同様である。 Q_{141} 、 Q_{142} および Q_{143} は、それぞれ一般式(V)における Q_8 と同義であり、また好ましい範囲も同様である。 R_{141} R_{142} および R_{143} は、それぞれ一般式(XI)における R_{11} と同義であり、また好ましい範囲も同様である。 R_{15} 0080)一般式(XI)で表される化合物のうち、

最も好ましくは下記一般式 (XV) で表される化合物で

ある。 【0081】 【化39】 - #82t (XV)

【0082】式中、Q₁₅₁: Q₁₅₂ およびQ₁₅₃ は、それぞれ一般式(V)におけるQ₈ と同義であり、また好ましい範囲も同様である。R₁₅₁: R₁₅₂ およびR₁₅₃ は、それぞれ一般式(XI)におけるR₁₁と回義であり、また好ましい範囲も同様である。

【0083】以下に本発明の一般式(I)で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

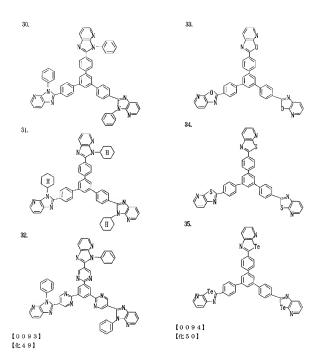
【0084】 【化40】

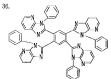


- $\begin{picture}(1,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\line(1,0){100$

[0086] 【化42]

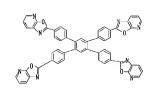
8. CH, H,C





38.

40.



41.

[0096]

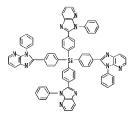
【化52】

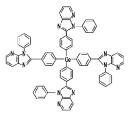
43.

[0097]

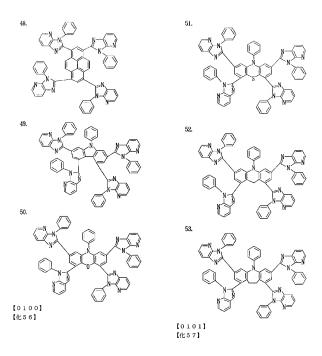
45.

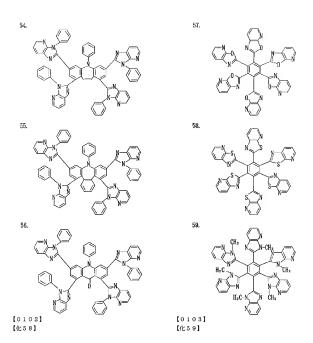
[0098]



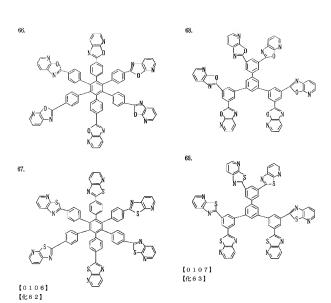


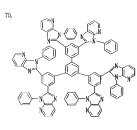
【0099】 【化55】

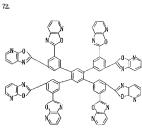


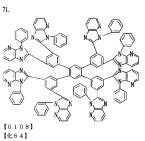


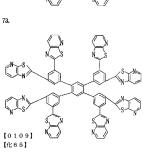
【0104】 【化60】 質量平均分子量 16,500 (ポリスチレン検算) 【0 1 0 5] 【化 6 1】



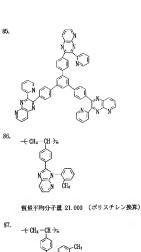








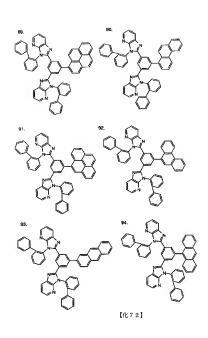
[0113] 【化69】



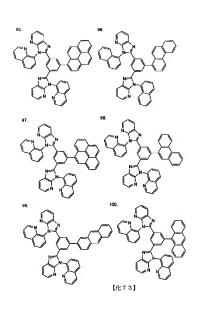
【化70】 \leftarrow CH₂ - CH \rightarrow _B

質量平均分子量 14,000 (ポリスチレン換算) 【0 1 1 4】

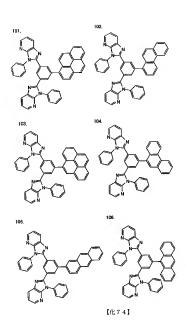
質量平均分子量 17,000 (ポリスチレン換算) m:n=1:1 (モル比) [0115] 【化71】



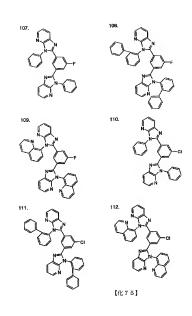
[0116]



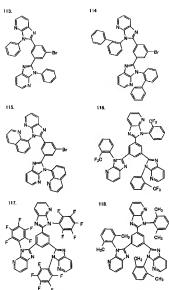
[0117]



[0118]



[0119]



[0 1 2 0] 一般式 (I) ~ (W) で奏される本発明の 化合物は、特公昭4 4 - 2 3 0 2 5 号、同 4 8 - 8 8 4 2 号、特問昭5 3 - 6 3 3 1 号、特開平10 - 9 2 5 7 8 号、米国特許3, 4 4 9, 2 5 5 号、同 5, 7 6 6, 7 7 9 号, J. Am. Chem. Soc., 9 4, 2 4 4 (1 9 7 2)、Hel v. Chim. Acta, 6 3, 4 1 3 (1 9 8 0)、Liebigs Ann. C hem., 1423 (1982) などに記載の方法を参 考にして合成できる。

【0121】以下に本発明の化合物の合成法について具体例をもって説明する。

合成例1. 例示化合物2の合成

[0122]

【化76】

【0123】1-1、化合物2aの合成 2-クロロ-3-ニトロピリジン50.8g(0.32 0モル)、炭酸カリウム90.8g(0.657モ ル)、ヨウ化銅(I) 7.90g(0.0416モ ル)、トルエン300ミリリットルを室温にて窒素雰囲 気下攪拌しているところへ、アニリン45.7g(0. 490モル)を加えた。5時間加熱還流した後、反応液 を濾過し、濾液を減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロ マトグラフィー (展開溶媒:クロロホルム) にて精製し た後、クロロホルム/ヘキサンにて再結晶することによ り化合物2 a を 4 5. 7 g (0. 21 モル) 得た。収率 66%

【0124】1-2. 化合物2bの合成

化合物2a 17.0g(0.0790モル)をテトラ ヒドロフラン170ミリリットルに溶解し、室温にて窒 素素囲気下槽拌しているところへハイドロサルファイト ナトリウム69.0g(0.396モル)/水220ミ リリットルの溶液を滴下した。1時間攪拌した後、酢酸 エチル170ミリリットルを加え、次に炭酸水素ナトリ ウム13.6g(0.162モル) /木140ミリリッ 例示化合物 2

トルの溶液を適下した。更に4.4'ービフェニルジカ ルボニルクロリド10.0g(0.0358モル)/酢 酸エチル100ミリリットルの溶液を滴下し、室温下5 時間攪拌した。析出した固体を濾取し、水、次いで酢酸 エチルで洗浄することにより化合物2bを16.0g (0,0277モル) 得た。収率77%

【0125】1-3. 例示化合物2の合成

化合物2b 10.0g(0.0173モル)、p-ト ルエンスルホン酸一水和物2.3g(0.0121モ ル) にキシレン300ミリリットルを加え、窒素雰囲気 下6時間加熱還流し、共沸脱水した。反応液を室温まで 冷却した後、析出した固体を濾取し、ジメチルホルムア ミド/アセトニトリルにて再結晶することにより例示化 合物2を5、20g(9、62ミリモル)得た。収率5 7 %

融点:298~300℃

【0126】合成例2、例示化合物18の合成

[0127]

[化77]

2a. (R=phenyl)

19a (R=3-methylphenyl)

20a (R=4-tert-butylphenyl)

21a (R=2-methylphenyl)

24a (R=8-quinolyl)

$$\begin{array}{c} 1) \underbrace{\begin{array}{c} Na_1s_10_4 \\ 2) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}}_{\quad \ \ \, C \cup C \cup C} \\ \begin{array}{c} R \\ NHC \\ O \\ NN \end{array} \\ \begin{array}{c} NHR \\ NHC \\ O \\ NN \end{array}$$

18b (R=phenyl)

19b (R=3-methylphenyl)

20b (R=4-tert-buty1pheny1)

21b (R=2-methylphenyl)

24b(R=8-quinolyl) 【化78】

[0128]

例示化合物18 (R=phenyl)

例示化合物19 (R=8-methylphenyl)

例示化合物20 (R=4-tert-butylphenyl)

例示化合物21 (R=2-methylphenyl)

例示化合物24 (R=8-quinoly1)

【0129】2-1. 化合物18 b の合成 化合物2a 15.0g(0.0697モル)をテラ ヒドロフラン150 ミリリットルに溶解し、盗鼠にて窒 素雰囲気下攪拌しているところへハイドロサルファイト ナトリウム60.9g(0.345モル)/水2005 リリットルの溶液を滴下した。2時間攪拌した後、酢酸 エチル150ミリリットルを加え、次に炭酸水素ナトリ ウム12.0g(0.143モル)/水120ミリリットルの溶液を滴下した。更にトリメシン酸クロリド5. 2g(0.0196モル)/酢酸エチル50ミリリット ルの溶液を漸下し、窓屋下3時間操作した。反応軟に動 和食塩水を加え、酢酸エチルにて抽出した後、有機相を 整和食塩水で洗浄し、有機相を無水硫酸ツグネシウムに より乾燥した。溶鉱を側圧倒走し、シリカゲルカラムク ロマトグラフィー (展開溶鉱: クロロホルム/メタノー ル=10/1 (vol/vol)) にて精製した後、ジ メチルホルムアミド/アセトニトリルにて再結晶するこ とにより化合物18bを4、1g(5.76ミリモル) 得た。収率29%。

【0130】2-2. 例示化合物18の合成

化合物18 b 3.70 g (5.20ミリモル)、pートルエンスルホン酸ー木和物0.7 g (3.68ミリモル)にキシセン100ミリリットルを加え、電素雰囲気下3時間加熱運流し、共沸脱水した。反応液を室温まで冷却した後、溶縦を破圧倒去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロコホルムメタノールに下青結晶することにより例示化合物18を1.70 g (2.58ミリモル)得た。収率50%。 概述:279~281℃

【0131】合成例3. 例示化合物19の合成 3-1. 化合物19aの合成

2-9ロロー3ーニトロピリジン50.0g(0.31 5モル)、炭酸カリウム90.8g(0.657モル)、ョウ化鋼(1)7.90g(0.0416モル)、トルエン300ミリットルを室程にて窒素雰囲気下慢拌しているところへ、mートルイジン45.0g(0.420モル)を加えた。8時間加熱潜滅上人な反応液を維急し、滤液を被圧兼縮した。ソカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:9ロロホルム)にて特製した後、9ロロホルム/ヘキサンにで再結晶することにより化合物19aを51.0g(0.222モル)得た。仮率11%

【0132】3-2. 化合物19bの合成

化合物19a 32.5g(0.142モル)をテトラ ヒドロフラン320ミリリットルに溶解し、室温にて窒 素雰囲気下攪拌しているところへハイドロサルファイト ナトリウム124g(0.712モル)/水320ミリ リットルの溶液を滴下し、次いでメタノール100ミリ リットルを加えた。1時間攪拌した後、酢酸エチル38 0ミリリットルを加え、次に炭酸水素ナトリウム24. 4 g (0, 290モル) / 水55ミリリットルの溶液を 滴下した。更にトリメシン酸クロリド10.5g(0. 0396モル) /酢酸エチル100ミリリットルの溶液 を滴下し、室温下3時間攪拌した。反応液に飽和食塩水 を加え、酢酸エチルにて抽出した後、有機相を飽和食塩 水で洗浄し、有機相を無水硫酸マグネシウムにより乾燥 した。溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (展開溶媒:クロロホルム/メタノール=10 /1 (vol/vol)) にて精製することにより化合 物19bを10, 2g (0, 0135モル) 得た。収率 3 4 %.

【0133】3-3. 例示化合物19の合成

化合物 19 b 3.30 g (4.38 ミリモル)、pートルエンスルホン酸ー水和物0.5 g (2.63 ミリモル)にキシヒン50ミリリットルを加え、電素雰囲気下3時間加熱電流し、共沸脱木した。反応被を窓温まで冷却した後、溶媒を液圧倒去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム/メタノール=20/1 (vol/vol))にて精製した後、クロロ

ホルム/メタノールにて再結晶することにより例示化合 物19を1.97g(2.81ミリモル) 得た。収率6 4%。

融点:258~259℃

【0134】合放例4、例示化合約20の合成 4-1. 化合物20aの合成 2-クロロー3-=トロピリジン45.5g(0.28 6モル)、炭酸カリウム81.1g(0.587モル)、トルエン300ミリリットルを室塩にて室業雰囲 気下機計しているところへ、4-tertープチルアニ リン40.0g(0.268モル)を加えた。8時間加 熱運流した後、反応被を濾過し、濾液を減圧濃縮した。 シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開線後:クロ コホルム)に下側製した後、タロコホルム/ペキサンに

(0.192モル) 得た。収率72% 【0135】4-2. 化合物20bの合成

て再結晶することにより化合物20aを52.0g

化合物20a 34.8g(0.128モル)をテトラ ヒドロフラン350ミリリットルに溶解し、室温にて窒 素雰囲気下機拌しているところへハイドロサルファイト ナトリウム112g(0.643モル)/水320ミリ リットルの溶液を滴下し、次いでメタノール90ミリリ ットルを加えた。1時間槽拌した後、酢酸エチル350 ミリリットルを加え、次に炭酸水素ナトリウム22.0 g (0.262モル) /水50ミリリットルの溶液を満 下した。更にトリメシン酸クロリド9.5g(0.03 58モル) /酢酸エチル90ミリリットルの溶液を滴下 し、室温下2時間攪拌した。反応液に飽和食塩水を加 え、酢酸エチルにて抽出した後、有機相を飽和食塩水で 洗浄し、有機相を無水硫酸マグネシウムにより乾燥し た。溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロマトグラ フィー (展開溶媒:クロロホルム/メタノール=10/ 1 (vol/vol)) にて精製することにより化合物 20bを12.0g(0.0136モル)得た。収率3

【0136】4-3. 例示化合物20の合成

化合物 20 b 3.00g(3.41ミリモル)、pートルエンスルホン酸ー水和物の.3g(1.58ミリモル)にキシレン50ミリリットルを加え、窒素雰囲気下3時間加熱蒸液し、共沸脱木した。反応被を登留まで冷却した後、折出した固体を離取した後、クロロホルム/メタノールにて再結曲することにより例示化合物 20を2.06g(2.49ミリモル)得た。収率73%。 機能 3:30°C以上

【0137】合成例5. 例示化合物21の合成 5-1. 化合物21aの合成

2-クロロー3-ニトロピリジン50.0g(0.31 5モル)、炭酸カリウム90.8g(0.657モル)、ヨウ化銅(1)7.90g(0.0416モ ル)、トルエン300ミリリットルを盗傷して窒素券四 気下機拌しているところへ、ロートルイジン45.0g (0.420モル)を加えた。8時間加熱避滅した後、 反応液を濾過し、遮液を減圧過縮した。シリカゲルカラ ムクロマトグラフィー (展開常盤:クロロボルム)にて が製した後、クロロホルム/・キサンにで解乱するこ

とにより化合物21aを46.3g(0.202モル)

得た。収率64% 【0138】5-2、化合物21bの合成 化合物21a 32,5g(0,142モル)をテトラ ヒドロフラン320ミリリットルに溶解し、室温にて窓 素雰囲気下槽拌しているところへハイドロサルファイト ナトリウム124g (0.712モル) /水320ミリ リットルの溶液を滴下し、次いでメタノール100ミリ リットルを加えた。1時間攪拌した後、酢酸エチル38 0ミリリットルを加え、次に炭酸水素ナトリウム24. 4g(0,290モル)/水55ミリリットルの溶液を 滴下した。更にトリメシン酸クロリド10.5g(0. 0396モル) /酢酸エチル100ミリリットルの溶液 を滴下し、室温下3時間攪拌した。反応液に飽和食塩水 を加え、酢酸エチルにて抽出した後、有機相を飽和食塩 水で洗浄し、有機相を無水硫酸マグネシウムにより乾燥 した。溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロマトゲ ラフィー (展開溶媒:クロロホルム/メタノール=10 /1 (vol/vol)) にて精製することにより化合

【0139】5-3. 例示化合物21の合成

8%.

物21bを8.5g(0.0112モル)得た。収率2

【0140】合成例6.例示化合物24の合成6-1.化合物24aの合成

2-クロロー3ーニトロピリジン59.0g(0.34 7モル)、炭酸カリウム105g(0.760モル)、 ヨウ化銅(1)9.40g(0.0494モル)、トル エン300ミリリットルを室温にて窒素雰囲気下機种しているところへ、8ーアミノキノリン75.0g(0、520キル)を加えた。16時間加熱透流した後、反応液を濾過し、濾波を減圧薬量した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム)にて精製した後、クロロホルム/〜キサンにて再結過することにより化合物24aを27.0g(0、102モル)得た。収率29%

【0141】6-2、化合物24bの合成

化合物24a 25.0g(93.9ミリモル)をテト ラヒドロフラン220ミリリットルに溶解し、室温にて 窒素雰囲気下攪拌しているところへハイドロサルファイ トナトリウム82.2g(0.472モル)/木420 ミリリットルの溶液を滴下し、次いでメタノール70ミ リリットルを加えた。1時間攪拌した後、酢酸エチル3 80ミリリットルを加え、次に炭酸水素ナトリウム2 4.4g(0.290モル)/水55ミリリットルの溶 液を滴下した。更にトリメシン酸クロリド7.55g (28.4ミリモル) /酢酸エチル100ミリリットル の溶液を滴下し、室温下3時間機拌した。反応液に飽和 食塩水を加え、酢酸エチルにて抽出した後、有機相を飽 和食塩水で洗浄し、有機相を無水硫酸マグネシウムによ り乾燥した。溶媒を減圧留去し、シリカゲルカラムクロ マトグラフィー(展開溶媒:クロロホルム/メタノール =10/1 (vol/vol)) にて精製することによ り化合物24bを7.86g(9.09ミリモル)得 た。収率32%。

【0142】6-3、例示化合物24の合成

化合物 24 b 5.00 g (5.78 \pm 9 \pm 9 \pm 9 \pm 10.1 kg \pm 10.1 kg \pm 10.2 kg \pm 10.2 kg \pm 10.3 kg

融点:384℃ 【0143】合成例7. 【0144】 【化79】

例示化合物10

【0145】7-1、化合物101bの合成 化合物2a50.0g(0.232モル)をテトラヒド ロフラン500ミリリットルに溶解させ、窒素雰囲気 下、室温で攪拌しているところに、ハイドロサルファイ トナトリウム200g (1. 149モル) /水700ミ リリットルの溶液を滴下した。更にメタノール20ミリ リットルを加えて、1時間攪拌した。次に、酢酸エチル 500ミリリットルを加えて、炭酸水素ナトリウム40 g (0、476モル) /水400ミリリットルの溶液を 加えた。更に5-プロモイソフタロイルクロリド65. 4g(0.232モル)/酢酸エチル150ミリリット ルの溶液を滴下し、室温で5時間攪拌した。酢酸エチル で抽出し、水、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸 マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。シリカゲ ルカラムクロマトグラフィー (展開溶媒:クロロホル ム) で精製した後、クロロホルム/ヘキサンで再結晶す ることにより化合物101bを29.6g(0.051 モル) 得た。収率22%。

【0146】7-2. 化合物101cの合成 化合物101b30g(0.05モル)をキシレン1リ リトルに綺麗させ、pートルエンスルおン隆 水和物 4.7g(0.025モル)を加え、蓬薬雰囲気下、2 時間加機監派しながら共膨胀水を行った。 反応液を宝温 まで冷却した後、折出した固体を譲取し、エタノール/ クロロホルムで再結晶することにより、化合物101c を16.3g(0.03モル)得た。 収率58%。 【0147】7-3.例示化合物101の合成 化合物101c5003リカー(0.02メール) と化合物101d332ミリグラム(1.01ミリモリル)をエチレングリコールジメチルエーテル20ミリリリトルおよび水10ミリリットルに懸濁させた。この懸濁液に反験ナトリウム2145ミリグラム(2.02ミリモル)、バラジウムカーボン15ミリグラム、2.0時間が震温化た。加熱停止後、熱停電温で触線を除る。 灌液と 酢酸エチルで抽出後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶鉱留去した。 残虚をクロロホルムから再結晶し、例示化合物101を180ミリグラム(0.27ミリモル)得た。収率29%。

【0148】 灰に、本発明の化合物を含有する発光素子 に関して説明する。本発明の化合物を含有する発光素子 の有機縁の形成方法は、特に限定されるもので注定い が、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子 積層法、コーティング法、インクジェット法、印刷法な どの方法用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、 コーティング法が好ましい。

【0149】本発明の化合物を発光素子用材料として用いた場合、ホール注入・輸送層、電子注入・輸送層、発 光層のいずれに用いてもよいが、電子注入・輸送層およびメまたは棄光層として用いることが好ましい。

【0150】本発明の発光素子は温極、陰極の一対の電 機関に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄 腰を形成した業子であり、発光層のほか正れ往入層、正 相輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有し でもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備え たものであってもよい、各層の形成にはそれぞれ種々の 材料を用いることができる。

【0151】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層な どに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用 いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材 料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電性金 属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常 $10nm\sim5\mu$ mの範囲のものが好ましく、よ り好ましくは50nm $\sim 1 \mu$ mであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0152】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ ラスを用いる場合には、通常 O. 2 mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法 (ゾルーゲル法など) 、酸化インジウム スズの分散物の途布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えばITOの場 合、UV-オゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ 5.

【0153】除椒は電子は入腸、電子輸送腸、発光層な 屋、発光層などの食糧と降後する局であり、電子往入層、電子輸送 層、発光層などの食糧と降後する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性等を考慮して溜ばれる。除極の 物、またはこれらの混合物を用いることができ、具体例 としては立馬、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いることができ、具体例 としてはアルカリ金属(例えばLi、Na、K、Cs 等)またはそのフッ化物、酸化物、アルカリエ角金属 (例えばMg、Ca等)またはそのフッ化物、酸化物、 金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金 またはそれの混合金属、サウムーアルラウムーのよ合金 またはそれらの混合金属、マグネシウム一般合金または それらの混合金属、マグネシウム一般合金または それらの混合金属が多がられ、チェビくは仕事制度が4を V以 土類金属等が影がられ、チェビくは仕事制度が4を V以 下の材料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムーアルミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウムー最体金またはそれらの混合金属等である。除極のを厚は材料により適宜選択「能であるが、通常10mm~5μmであり、更に好ましくは、10mm~1μmである。降種の作製には電子ピーム法、スパッタリング法、抵抗加熱素着法、ユーティング法などの方法が用いられ、金属を単体で漂着することも、一成分以上を同時に素着することもできる。さらに、複数の金属を同時に素着することもできる。さらに、複数の金属を同時に素着して合金性種を形成することも同じなあり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。陽極及び発極のシート抵抗は低い力が好ましく、数百0/□以下が好ましい。

【0154】発光層の材料は、電界印加時に陽極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよい。発光層に用いる化合物としては励起一重項 状態から発光するもの、励起三重項状態から発光するも ののいずれでもよく、例えば本発明の化合物のほか、例 えばペンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘 導体、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導 体、ポリフェニル誘導体、ジフェニルブタジエン誘導 体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド 誘導体、クマリン誘導体、ペリレン誘導体、ペリノン誘 導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ピ ラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピススチ リルアントラセン誘導体、キナクリドン誘導体、ピロロ ピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、シクロ ペンタジエン誘導体、スチリルアミン誘導体、芳香族ジ メチリディン化合物、8-キノリノール誘導体の金属錯 体、遷移金属錯体(例えば、トリス(2ーフェニルピリ ジン) イリジウム (III)などのオルソメタル化錯体等) や希土類錯体に代表される各種金属錯体等、ポリチオフ エン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン、ポリ フルオレン等のポリマー化合物等が挙げられる。発光層 の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1nm~ 5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm $\sim 1 \mu m$ であり、更に好ましくは $10 nm \sim 500 nm$ である。発光層の形成方法は、特に限定されるものでは ないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、 分子積層法、コーティング法 (スピンコート法、キャス ト法、ディップコート法など)、インクジェット法、印 刷法、LB法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加 熱蒸着、コーティング法である。

【0155】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から

注入された電子を障壁する機能のいずれかを有している ものであればよい。その具体例としては、カルバゾール 誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オ キサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリ ールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘 導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポリフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ(N-ビニルカルバゾール) 誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー、カーボン膜等が挙げられる。正 孔注入層、正孔輸送層の膜厚は特に限定されるものでは ないが、通常 $1nm\sim5\mu m$ の範囲のものが好ましく、 より好ましくは5 nm~1 μmであり、更に好ましくは 10nm~500nmである。正孔注入層、正孔輸送層 は上述した材料の1種または2種以上からなる単層構造 であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層か らなる多層構造であってもよい。正孔注入層、正孔輸送 層の形成方法としては、真空蒸着法やLB法、前記正孔 注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させてコーティング する方法(スピンコート法、キャスト法、ディップコー ト法など)、インクジェット法、印刷法などが用いられ る。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解または 分散することができ、樹脂成分としては例えば、ボリ塩 化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチ ルメタクリレート、ポリプチルメタクリレート、ポリエ ステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリ プタジエン、ポリ (N-ビニルカルバゾール)、炭化水 素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エ チルセルロース、酢酸ピニル、ABS樹脂、ポリウレタ ン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド 樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。 【0156】 電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。好ましくは電子注入層及び/又は電子 輸送層に本発明の化合物を含有するものであるが、本発 明の化合物の他の材料を用いることもできる。その具体 例としては、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導 体、オキサジアゾール誘導体、フルオレノン誘導体、ア ントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェ ニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カル ボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジ スチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン等の複素 環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8 ーキノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニ ン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子と

する金属錯体に代表される各種金属錯体等が挙げられ る。電子注入層、電子輸送層の際厚は特に限定されるも のではないが、通常1nm~5μmの範囲のものが好ま しく、より好ましくは $5nm\sim1\mu m$ であり、更に好ま しくは10nm~500nmである。電子注入層、電子 輸送層は上述した材料の1種または2種以上からなる単 層構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複 数層からなる多層構造であってもよい。電子注入層、電 子輸送層の形成方法としては、真空蒸着法やLB法、前 記載子注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させてコーテ ィングする方法 (スピンコート法、キャスト法、ディッ プコート法など)、インクジェット法、印刷法などが用 いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解 または分散することができ、樹脂成分としては例えば、 正孔注入輸送層の場合に例示したものが適用できる。 【0157】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn. Pb. Au, Cu. Ag, Al, Ti, N i等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2O3、 GeO, NiO, CaO, BaO, Fe₂O₃, Y₂O₃ 、TiO。等の金属酸化物、MgF。、LiF、Al F。、CaF。等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリ プロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、 ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロ トリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレ ン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロ エチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少な くとも1種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重 合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有 する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、 吸水率0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護 層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸 着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、M BE (分子線エピタキシ) 法、クラスターイオンビーム 法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波 励起イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レ ーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コ ーティング法、インクジェット法、印刷法などを適用で きる。

[0158]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発別を具体的に説別するが、本発明はこれにより限定されるものではない、実施例1. 洗浄した $| 15 \rangle$ T での機材 $| 15 \rangle$ T での機材 $| 15 \rangle$ T で $| 15 \rangle$ T で

ム:銀=10:1を250nm共蒸着した後、銀300 nmを蒸着し(10×10 30 -1.3×10 30 -1.3×10 30 -1.3×10 30 -1.5×

た。また、作製した素子を85℃、70%RHの条件下 に3日間放置後発光させた相対理度(素子作製直後の理 度を100とした場合の経時後の理度を相対値で表した 値(駆動電圧10V))および解光面のゲークスポット (未発光部)の有無を目視評価した。結果を表1に示

【0159】 【表1】

表 1

試料	the A thin	発光波長	最高輝度	CIE色度座標	最低駆動	経時後の	ダークス	備考
No.	化合物	λmax(nm)	(cd/m²)	(x, Y)	電圧(V)	相対輝度	が発生	選与
101	比較化合物 1	460	410	(0.16, 0.15)	6	77	無	比較例
102	比較化合物 2	445	230	(0.15, 0.15)	7	12	有	"
103	例示化合物 2	465	1620	(0.16, 0.15)	4	82	無	本発明
104	例示化合物18	463	1777	(0.16, 0.16)	4	91	無	"
105	例示化合物19	447	1650	(0.16, 0.17)	4	88	無	"
106	例示化合物21	420	1820	(0.15, 0.13)	4	93	無	"
107	例示化合物24	432	1900	(0. 15. 0. 14)	4	94	無	"

[0160] [(E80]

比較化合物 1



特開平10-92578号記載化合物

比較化合物 2 (PRII)

【0161】表1の結果より、本発明の化合物を用いる と非ドーブ型の素子でも高頭変で色純度良好な青色発光 が可能であることがわかる。また、高温保管後の輝度低 下、ダークスポットの発生も少なく耐久性に優れている ことがわかる。

【0 1 6 2 1 実施例 2 実施例 1 と同様に I T O 基板を 洗冷後、網 フタロシアニンを原厚 5 n m、N P D を 膜厚 4 0 n m、青色系光材料 A を 原写 2 0 n m、表 2 記載の 化合物を 瞑厚 4 0 n m となるようにこの順に 英空蒸掉 (1.0 × 10 ⁻³ − 1.3 × 10 ⁻³ P a 1.0 c c c の上に バ ターニング したマスク (発光面積が 4 m m × 5 m m と な るマスク)を 設置し、マグネシウム: 毎 = 10 : 1 を 2 5 0 n m 共 素着 した後、振 3 0 0 n m を 蒸着 し 1.0 で 10 ⁻³ − 1.3 × 10 ⁻³ P a 1.9 元美子を 作製した。 な お、作製した素子は乾燥グローブボックス内で封止し た。作製した素子は乾燥グローブボックス内で封止し た。 結果を変とに示す。

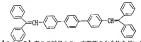
【0163】 【表2】

ā	₹2							
試料		発光波長	最高輝度	CIE色度座標	最低駆動	経時後の	ダークス チェト	備考
No.	化合物	λmax(nm)	(cd/m²)	(x, Y)	電圧(V)	相対輝度	お 発生	110,00
201	比較化合物 1	460	510	(0.15, 0.15)	6	79	無	比較例
202	比較化合物 2	462	320	(0.15, 0.15)	7	19	有	"
203	例示化合物18	462	3040	(0.15, 0.15)	4	83	無	本発明
204	例示化合物19	462	2780	(0.15, 0.16)	4	92	無	"
205	例示化合物21	461	3820	(0.15, 0.14)	4	94	無	"
206	例示化合物24	462	4040	(0.15, 0.14)	4	98	無	"
207	例示化合物26	461	2650	(0, 15, 0, 15)	4	81	無	"
208	例示化合物81	464	2430	(0.15, 0.15)	4	80	無	"

比較化合物1、2は実施例1と同じ。

【0164】 【化81】

青色発光材料 A



【0 1 65 1 表 2 の結果より、本発明の化合物を用いる と非ドープ型の菓子で電子輸送材として機能し、高輝度 で色純度良好な青色発光が可能であることがわかる。また、高温保管後の輝度低下、ゲークスポットの発生も少なく耐久性に優れていることがわかる。

【0166】実施例3.実施例1と同様にITO基板を 洗浄後、銅フタロシアニンを膜厚5nm、NPDを膜厚

【0167】 【表3】

5	€3					
試料		最高輝度(cd/m²)		CIE色度图	備考	
No.	化合物	8 V駆動時	15V駆動時	8 V駆動時	15V駆動時	Maria
301	比較化合物 3	475	2250	(0.15, 0.15)	(0.17, 0.25)	比較例
302	例示化合物 5	920	2890	(0.15, 0.15)	(0.15, 0.16)	本発明
303	例示化合物18	1040	3130	(0.15, 0.15)	(0.15, 0.16)	"
	例示化合物27	860	2840	(0, 15, 0, 15)	(0.15, 0.15)	"
304	例示化音物20	740	2600		(0.15, 0.16)	"

【0168】 【化82】

比較化合物 3 (Alq)



【0169】表3の結果から明らかなように、本発明の

化合物を用いた素子では、蛍光性化合物をドープした素 でも高輝度発光が可能であることが刺る。またA1qを ホストに用いた素子では駆動電圧を高くすると青色頻度 が低ドするのに対し、本発明の化合物をホストに用いた 素子では色純度の変化が新と見られず、色純度の高い高 輝度発光が可能であることが利る。

【0170】実施例4. ポリ (N−ビニルカルパソール) 40mg、青色発光材料B10.0mg、緑色発光材料52.0mg、赤色光光材料R0.5mg、表4記載の化合物12.0mgを1,2−ジクロロエタン3m

Iに溶解し、洗浄した1Tの基板上にスピンコートした。 生成した有機薄板の原厚は、約110mmであった。 有機薄膜にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなるマスク)を設置し、次いでA1: Li=100:2比で原厚200mとなるように共端をして発光素子を作製した。この素子を実施例1と同様な方法で発した。この素子を実施例1と同様な方法で評価した。結果を表4に示す。

【0171】 【表4】

....

ZQ 4						
試料	化合物	最低駆動	最高輝度	CIE色度座標	ダークス ポット 発生	備者
No.	化合物	電圧(V)	(cd/m²)	(x,Y)	発生	Ma. 3
401	比較化合物 2	1.4	425	(0.32, 0.35)	有	比較例
402	例示化合物 3	9	3030	(0.34, 0.35)	無	本発明
403	例示化合物 4	9	2760	(0.34, 0.36)	無	"
404	例示化合物 5	8	3270	(0.33, 0.36)	無	"
405	例示化合物18	8	4150	(0.33, 0.36)	無	"
406	例示化合物27	9	3050	(0.84, 0.35)	無	"

比較化合物は実施例1と同じ。

[0172]

【化83】

青色発光材料 B

绿色拳光材料G

赤色発光材料R

【0173】素4の結果から明らかなように、本発明の 化合物を用いた票子では、比較化合物に比べ、通常発光 螺度が低い途布方式においても低電圧駆動、高脚度発光 が可能であることが判る。また、比較化合物2 (PB D) を用いた票子ではダークスポットの発生が顕著に見 られるのに対し、本発明の半ででは良好な面が栄光を示 した。更に、本発明の半合物を用いて青色、緑色および 赤色亮光柱神を組み合わせて用いると良好な白色発光が 可能なことが知る。

【0174】実施例5、実施例1と同様に I TO基板を 洗浄後、N P D を 機厚50 nm、4、4 'ーピス (カル バゾールー9 ール) ピフェニルおよびトリス (2 ーフ ェニルピリジン) イリジウム (III)をそれぞれ蒸着速度 0.4 nm / 秒,0025 nm / 秒で機厚20 nm なるように共薫着し、次いで例示化合物21を機厚25 nm蒸着し、更にLiFを機厚1 nm蒸着 (1.0×1 0 "3 ~ 1.3×10 "3 P a) した。この上にバターニン グしたマスク (発光面積が4 mm、75 mmとなるマップ り を設置し、アルミニウムを200 nm蒸着 (1.0 (H₁ ×10⁻³~1.3×10⁻³Pa) して素子を作製した。 作製した素子について評価した結果、緑色で最高輝度9 ສ、000cd/m²、外部量子効率14%の高輝度、高効 率発光が続られた。

「10.1751 実施例6. 実施例1と同様に1TO基板を 洗浄した後、Baytron P (PEDOT-PSS 溶液 (ポリジオキシエチレンーポリスチレンスルホン酸 ドープ体) //イイエル社製)を2000rpm、60秒 マスピンコートした後、100℃で1時間真空磁場し、 ホール輸送性膜を作製した(原原約100nm)。この 上にポリ(9,9 ラージオクラルアルオレン)20mgを クロロホルム2ミリリットルに溶かした溶液をスピンコート(1000rpm、20秒)した(腹原約70nm m)。この上に何示化合約18を腕厚30nm真空蒸着 (1.0×10⁻³~1.3×10⁻³Pa)した。次いで この有機薄膜にバタケーニングしたマカク(発売積が 4mm×5mmとなるマスク)を設置し、実施例1と同様にして機棒を蒸着し、素子を作製した(本果卵素 デ)。また、性酸素ととして油素子作製工程によいす。 【0 1 7 6 】 装施例 7、実施例 1 と同様に 1 T O 基板を 洗浄した後、B a y t r o n P (PEDOT - PS S 溶液 (ポリジオキシエチレンーポリステレンスルコン酸 ドーブ体) ノバイエル社製) を2 0 0 0 r p m、6 0 秒 でスピンコートした後、1 0 0 ℃で2時間真空乾燥し、 ホール輸送性験を作製した (膜厚約 1 0 0 n m)。この 上にポリ (N - ビニルカルバゾール) 4 0 mg、PB D 1 2 mg およびドリス (2 - フェニルビリジン) イリジ ウム (III) 1 mgをクロコホルム3 ミリリットルに 溶解した溶液をスピンコート (1 5 0 0 r p m、2 0 砂) した (膜厚約 6 0 n m)。この上に何水化合物 2 1 を膜厚 2 0 n m真空蒸着 (1.0 × 10 ⁻³ ~ 1.3 × 1 0 ⁻³ P a) し、更に上 i F を膜厚約 1 n m 添着 (1.0 × 10 ⁻³ ~ 1.3 × 10 ⁻³ P a) した。この上にパター ニングしたマスタ(発光面積が4mm×5mmとなるマスタ)を設置し、アルミニウムを200mm業者(1.0×10⁻³⁰-1.3×10⁻³⁰-1.1以下を特別とた体制をした本子を作製した体発明素子)。また、比較素子として上記素子作製した体系といた研究と合物21を除いた素子を作製した。作製した素子について評価した結果、比較素子では発光輝度1000cmがあったが、1000cmがあったが、1000cmがあったが、1000cmがあったが、1000cmがあったが、1000cmがあったが、1000cmがあったが、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが出来の表が、1000cmが、1

[0177]

【発明の効果】本発明の化合物により、ドープ型および 非ドープ型素子のいずれにおいても色物度良好な高輝度 育色発光素子の作製が可能となり、また近常皿の吸収 に発光可能な条子が提供できる。また、通常無度の低い 塗布方式でも良好な発光特性が得られ、製造コスト面等 で有利な素子作製が可能である。更に、耐火性が良好 で、駆動電圧の違いによる色度変化も小さい有機発光素 子が得られる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
C O 7 D 519/00	3 1 1	C 0 7 D 519/00	3 1 1
C 0 7 F 7/08		C 0 7 F 7/08	R
7/30		7/30	F
H 0 5 B 33/14		H O 5 B 33/14	В
33/22		33/22	В
// C 0 8 F 12/26		C 0 8 F 12/26	
226/06		226/06	

F ターム(参考) 3K007 ABO1 AB12 AB17 AB18 CAO1 CBO1 CBO3 AB03 MAI10 UU05 4H049 VN01 VN02 VP01 VQ60 VQ84 VR21 VU29 VW01 4J100 AB07F AQ264 BC43P BC559 BC579 BD15P CAO1 CA04

DA01 JA32